

半导体学报

第2卷 第1期 1981年2月

目 录

- 极性晶体中激子的性质.....梁希侠 顾世清 (1)
- 掺 Te-GaAs 单晶微缺陷微沉淀的研究.....
.....何宏家 曹福年 范缙文 白玉珂 费雪英 王凤莲 (7)
- InSb 质子轰击损伤的隔离效应.....赵文琴 (14)
- 光敏三极管时间参数的瞬态分析.....何民才 赵小敏 (22)
- 雪崩光电二极管体内漏电流的测量分析.....石仲斌 (29)
- IMPATT 雪崩二极管大信号理论分析.....杨玉芬 (36)
- 具有 $PTF > 1$ 及均匀载流子漂移速度的硅雪崩二极管的理论分析.....唐惟琅 (45)
- 一种快速多用途 TD-TTL 弛豫振荡器.....邓兆扬 (55)

研究简报

- MIS 多晶硅太阳能电池的 AES 和 ESCA 分析.....
.....李炳胜 王佑祥 余海仁 许振嘉 (65)
- 硅中金杂质分布的测量.....周洁 王杏华 李树英 (71)
- 四探针测圆形薄片电阻率的计算公式.....陈学全 包德修 (74)
- $\text{SiCl}_4/\text{SiH}_4\text{-NH}_3$ 体系的低压化学蒸汽沉积 (LPCVD) 氮化硅薄膜研究.....
.....王季陶 吕以金 承焕生 吴宪平 (78)

会议简讯

- 第一届全国“三束”学术年会简讯.....刘宗德 (81)
- 全国半导体计算机辅助设计和模拟学术会议..... (82)
- 第一届全国半导体表面、界面物理学术会议简讯.....马国风 邢步高 (83)
- 第二届全国集成电路和硅材料学术会议征文启事..... (84)